



بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه خوارزمی،
تهران، ایران.
۱۵-۱۶ بهمن ۱۳۹۸



طراحی و ساخت تقویت کننده میکرولیزر سوئیچ-Q انفعالی به روش جاروب پرتو دمش جذب نشده

سمیرا علیپور*، مریم جندقی، زهرا محمدظاهری، المیرا حاجی نیا، سعید سلیمیان ریزی، محمد جوادی
داشکسن، سید حسن نبوی

مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

*Email: alipour@inlc.ir

چکیده- میکرولیزرها به دلیل ابعاد کوچک تشدیدگر و جذب ناکافی پرتو دمش، راندمان تبدیل نوری پایینی را دارا می باشند. در این تحقیق طراحی و ساخت سیستم تقویت کننده میکرولیزر به روش جاروب پرتو دمش جذب نشده در تشدیدگر اولیه انجام شده است. در این روش تقویت انرژی میکرولیزر تا سه برابر انرژی اولیه با یک بار عبور انجام گردیده و بیشترین انرژی بدست آمده پس از تقویت مقدار ۱۹۳μJ است. در این روش تقویت میکرولیزر، با کمترین پیچیدگی و هزینه اضافی انجام شده است.

کلید واژه- میکرولیزر سوئیچ Q انفعالی، تقویت کننده، جاروب پرتو دمش

Design and fabrication of Energy Scavenging amplifier for Passively Q-switched microchip laser

Samira Alipour, Maryam Jandaghi, Zahra Mohammad Zahery, Elmira Haji Nia, Saeed Salimian rizi, Mohammad Javadi Dashkasan, Seyyed Hasan Nabavi

Iranian National Center for Laser Science and Technology, P.O. Box 14665-576, Tehran, Iran

Abstract- Microchip lasers have low optical efficiency because of low absorption of pump light in small cavity. In this study energy scavenging amplifier for passively Q-switched microchip laser is designed and fabricated. The amplifying of energy is done with one pass amplifier in this research higher than 3 and the maximum energy of amplifier is 193μJ in this microchip laser. Enhance of energy is done with minimal cost and complexity in this method of Microchip laser amplifying.

Keywords: Passively Q-Switched Microchip Laser, Amplifier, Pump Scavenging

مقدمه

میکرولیزرهای سوئیچ Q انفعالی مشخصه‌های بسیار جالب و کاربردهای فراوانی را دارا می‌باشند [۱]. با این حال راندمان نسبتاً پایین آن‌ها مانعی بر سر راه استفاده از این دست از لیزرها در مواردی که نیاز به انرژی بالا است، می‌باشد. راندمان پایین تولید این لیزرهای دمش شده‌ی طولی، ناشی از جذب ناکارآمد پرتو دمش به دلیل طول کوتاه محیط بهره است. این مشکل در میکرولیزرهایی که به منظور تولید تب‌های لیزری بسیار کوتاه طراحی می‌گردند و تشدیدگرهای بسیار کوچکی دارند، بسیار حایز اهمیت است. جاروب نور دمش جذب نشده به منظور دمش یک تقویت کننده در امتداد میکرولیزر، می‌تواند راندمان سیستم را با کمترین هزینه، سائزو پیچیدگی به بیش از ۲ برابر افزایش دهد [۲]. تقویت به روش جاروب پرتو جذب نشده‌ی دمش امکان افزایش انرژی تا ۳ برابر را فراهم می‌نماید. این تقویت اولین بار توسط J. J. Zayhowski در سال ۲۰۰۳ در یک اختراع به شماره‌ی ۶,۵۱۲,۶۳۰ مطرح شد [۳]. به منظور تقویت میکرولیزرها، عموماً از روش‌های متعددی از جمله تقویت با استفاده از لامپ، لیزرهای دیودی و همچنین فیبرهای بلور فوتونی استفاده می‌شود. در تمامی این روش‌ها با اعمال پرتو دمش با توان‌های بالا، می‌توان انرژی اولیه را تا چندصد یا چندین هزار برابر افزایش داد. این روش‌ها از هزینه، حجم و پیچیدگی بالایی برخوردار می‌باشند که در تمامی آن‌ها باید از یک چشمه‌ی دمش دیگر به منظور تقویت میکرولیزر استفاده نمود. با این حال در تمامی این روش‌ها برای به دست آوردن راندمان خروجی قابل قبول، مناسبتر است که انرژی اولیه‌ی لیزر تا آنجا که ممکن است افزایش پیدا کرده باشد. تقویت با استفاده از پرتو دمش جذب نشده، امکان افزایش انرژی میکرولیزرها را با استفاده از منبع دمش متعلق به میکرولیزر فراهم نموده به طوریکه با طراحی مناسب و استفاده از چند قطعه نوری و یک محیط بهره، بتوان انرژی این دسته از لیزرها را تا سه برابر افزایش داد. در میکرولیزرهایی با انرژی تب کوچک، نیاز به تخلیه-

ی انرژی بهینه از محیط بهره‌ی تقویت وجود دارد. بنابراین بلور Nd:YVO₄ به دلیل داشتن سطح مقطع جذب بزرگتر و چگالی توان اشباع کوچکتر نسبت به بلور Nd:YAG، گزینه‌ی مناسبتری برای این دسته از میکرولیزرها است.

تئوری

جاروب پرتو دمش جذب نشده در واقع استفاده از پرتو دمش جذب نشده توسط محیط بهره‌ی لیزر است به طوریکه بلافاصله پس از بلور اول با استفاده از سیستم اپتیکی، هر دو پرتو دمش و لیزر که با یکدیگر همراستا نیز می‌باشند درون بلور دیگری به منظور تقویت پرتو لیزر و استفاده از پرتو دمش جذب نشده متمرکز می‌گردند.

پارامترهای موثر در میزان تقویت یک تقویت کننده‌ی پالسی، چگالی انرژی ورودی به تقویت کننده، چگالی انرژی اشباع و بهره‌ی سیگنال کوچک هستند. بهره‌ی سیگنال کوچک یکی از مهمترین پارامترهای توصیف کننده‌ی یک تقویت کننده است که توسط رابطه‌ی زیر توصیف می‌شود [۴]:

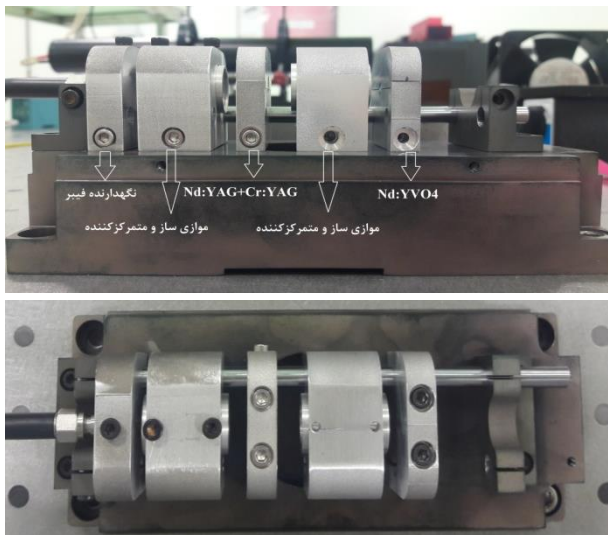
$$G_0 = \exp[\sigma_e L \iiint s_l(r, z) \Delta n(r, z) dV] \quad (1)$$

به طوریکه در اینجا σ_e سطح مقطع گسیل القایی بلور Nd:YVO₄ است که به شدت وابسته به دمای بلور است. L طول هندسی محیط فعال و $s_l(r, z)$ توزیع شدت بهنجار شده پرتو ورودی میکرولیزر در محیط بهره و $\Delta n(r, z)$ توزیع چگالی جمعیت در محیط بهره است که به توزیع شدت لیزر پمپ در محیط بهره که متأثر از پارامترهایی نظیر چگالی یون‌های جایگزیده، کیفیت پرتو M^2 و شعاع در مکان فوکوس لیزر پمپ می‌باشد، وابسته است.

به منظور طراحی تقویت با استفاده از پرتو دمش جذب نشده، از یک میکرولیزر سوئیچ Q انفعالی متشکل از یک محیط بهره‌ی Nd³⁺:YAG و یک محیط جاذب Cr⁴⁺:YAG که به صورت اتصال نفوذی به یکدیگر متصل شده‌اند، استفاده شده‌است. آئینه‌ی خروجی لیزر به صورت بازتاب نسبی برای طول موج ۱۰۶۴ nm و بیشینه‌ی عبور برای طول موج ۸۰۸nm، لایه‌نشانی شده است به طوریکه امکان پمپ برای محیط تقویت کننده با پرتو دمش جذب

می‌باشد. نرخ تکرار و پهنای تب این لیزر جهت بهینه سازی عمل تقویت تبها قابلیت تنظیم داشته و توان بیشینه $30W$ را در خروجی بدست می‌دهد.

بلور محیط تقویت $Nd:YVO_4$ به طول 5 میلی‌متر با چگالی یون‌های جایگزیده شده 1% اتمی و ورودی 3×3 میلی‌متر مربع است. به منظور موازی سازی و متمرکز نمودن پرتو دمش در هر دو مرحله نوسانگر اولیه (میکرولیزر) و تقویت از دو لنز مشابه با فاصله‌ی کانونی یکسان $f=18mm$ و بزرگنمایی 1 به 1 استفاده گردیده است. شکل زیر نمایی از میکرولیزر تقویت شده به روش جاروب پمپ جذب نشده را نشان می‌دهد. خنک‌سازی این لیزر به روش هوا خنک انجام می‌شود.



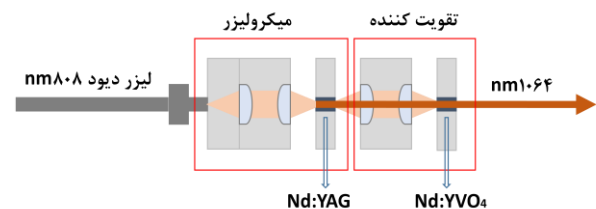
شکل ۲- میکرو لیزر تقویت شده به روش جاروب پرتو دمش جذب نشده.

پهنای تب بدست آمده از این لیزر 700 پیکوثانیه می‌باشد. شکل ۳ انرژی خروجی از میکرولیزر و انرژی پس از تقویت را در توان‌های دمش $26W$ - 30 و پهنای زمانی دمش $50\mu s$ را نشان می‌دهد. خروجی در هر حالت با بهینه سازی بزرگنمایی لنزها به دست آمده است. بهره‌ی بدست آمده در این آزمایش‌ها از $2,93$ تا $3,09$ متغیر می‌باشد.

نشده فراهم گردد. لیزر دیودی استفاده شده برای پمپ این سیستم، یک پرتو شبه پیوسته QCW است که نرخ تکرار و پهنای تب آن جهت بهینه‌سازی عمل تقویت تبها تنظیم می‌شود. همپوشانی نور پمپ و نور لیزر در بلور تقویت و تنظیم مناسب پهنای و نرخ تکرار تب‌های دمش جهت تقویت منظم تب‌های خروجی از میکرو لیزر در تقویت بهینه‌ی خروجی میکرو لیزر نقش موثری را ایفا می‌کنند.

مشاهدات تجربی

شکل ۱ شماتیکی از جزئیات سیستم تقویت به روش جاروب پمپ جذب نشده را نشان می‌دهد.



شکل ۱- شماتیک سیستم تقویت به روش جاروب پمپ جذب نشده

میکرولیزر سوئیچ Q انفعالی که متشکل از یک محیط بهره‌ی $Nd^{3+}:YAG$ به طول 1 میلی‌متر با چگالی یون‌های جایگزیده شده $1,1\%$ اتمی و یک محیط جذب $Cr^{4+}:YAG$ به طول 1 میلی‌متر که به صورت اتصال نفوذی به یکدیگر متصل شده‌اند می‌باشد، استفاده شده است. همچنین دو لایه‌ی YAG خالص به طول $0,5$ میلی‌متر در ورودی و خروجی تشدیدگر به صورت اتصال نفوذی قرار داده شده‌است تا به کاهش تنش‌های حرارتی و مکانیکی کمک نماید. آیینی‌ی خروجی لیزر به صورت بازتاب نسبی $R=55\%$ برای طول موج $1064nm$ و بیشینه‌ی عبور برای طول موج $808nm$ ، لایه نشانی گردیده‌است. همینطور عبور اولیه برای پرتو لیزر از بلور جاذب $T_0=55\%$ است.

لیزر دیود استفاده شده برای پمپ این سیستم، یک دیود متصل شده به فیبر با قطر 200 میکرومتر و $NA=0,22$ است که قابلیت عملکرد شبه پیوسته QCW را نیز دارا

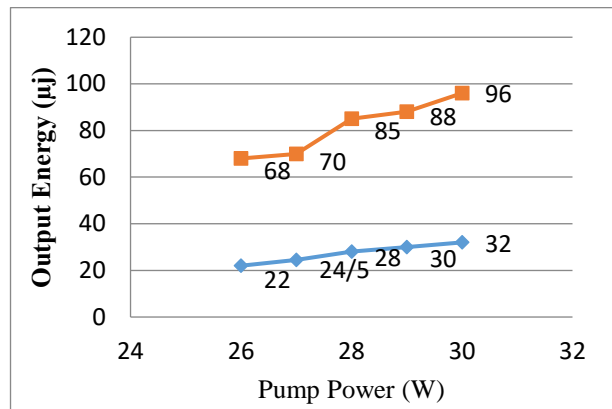
در راستای کارآمدی این نوع از لیزرها و استفاده‌ی هرچه بیشتر از آن‌ها در صنعت خواهد بود.

نتیجه‌گیری

در این تحقیق تقویت انرژی میکرولیزرها به روش جاروب پرتو دمش جذب نشده در میکرولیزر بررسی شده‌است. بدین منظور سیستم لیزری و تقویت کننده‌ای متشکل از بلور Nd:YVO_4 و $\text{YAG/Nd}^{3+}:\text{YAG/Cr}^{4+}:\text{YAG/YAG}$ طراحی و ساخته شد. از آنجاییکه میکرولیزرها راندمان تبدیل نسبتاً پایینی را دارا می‌باشند، استفاده از این روش راندمان تبدیل نوری این دسته از لیزرها را تا بیش از ۳ برابر افزایش می‌دهد. بیشینه انرژی بدست آمده از این نوع میکرولیزر $61.4\mu\text{J}$ بوده است که پس از تقویت تا مقدار $193\mu\text{J}$ افزایش پیدا کرده است. این روش قابلیت استفاده در تمامی میکرولیزرها را داشته، به طوری که بدون بالا رفتن جذب در تشدیدگر اولیه و افزایش پیچیدگی و هزینه‌ی لیزر، انرژی لیزر تا بیش از ۳ برابر افزایش پیدا می‌کند.

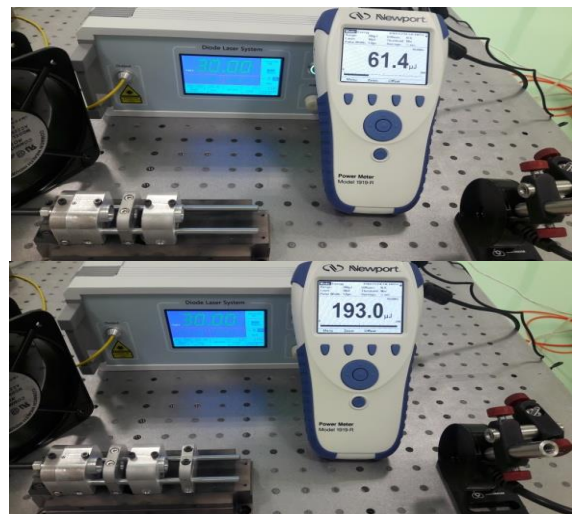
مرجع‌ها

- [1] J. J. Zayhowski and C. Dill, "Diode-pumped passively Q-switched picoseconds microchip lasers", Opt. Lett. 19, No.18, 1994.
- [2] J. J. Zayhowski and A. I. Wilson, "Energy Scavenging amplifiers for miniature solid state lasers" Opt. Lett. Vol. 20, No.11, 2004.
- [3] J. J. Zayhowski, "Miniature Lasers/Amplifier system", US Patent, Patent No.: US 6,512,630 B1, 2003
- [4] M. Nie, Q. Liu, et al. "Design of High Gain single stage and single pass Nd:YVO4 amplifier pumped by fiber coupled laser diodes: simulation and experiment", IEEE j. Quant. Elec. Vol. 52, No. 8, 2016



شکل ۳- انرژی خروجی از میکرولیزر (نقاط آبی) و تقویت کننده (نقاط نارنجی) برحسب توان دمش در پهنای زمانی $50\mu\text{s}$

بیشترین انرژی خروجی بدست آمده از این میکرولیزر در توان دمش 30W و پهنای تب $100\mu\text{s}$ بدست می‌آید که مقدار $61.4\mu\text{J}$ و $193\mu\text{J}$ به ترتیب قبل و پس از تقویت است (شکل ۴). بهره‌ی بدست آمده در این شرایط 3.14 می‌باشد که بیشترین مقدار تقویت به این روش است.



شکل ۴- چیدمان آزمایشگاهی میکرولیزر تقویت شده به روش جاروب پمپ جذب نشده و انرژی خروجی از میکرولیزر (شکل بالا) و تقویت کننده (شکل پایین)

تقویت به روش جاروب پمپ جذب نشده در میکرولیزرها قابلیت افزایش انرژی نوسانگر اولیه را تا بیش از ۳ برابر فراهم می‌نماید. این قابلیت، افزایش انرژی میکرولیزرهای توان بالا را تا 0.5mJ و بالاتر، بدون استفاده از دمش اضافی و بزرگ شدن سیستم امکان پذیر می‌نماید که قدم بزرگی